# COATING FILM HANDER LOW REFRACTIVE INDEX AND WATER REPELLENCY

Patent number:

JP9208898

**Publication date:** 

1997-08-12

Inventor:

NOGAMI TATSUYA; NAKADA TAKAKAZU; SAKAI RIE;

HOSOYA TAKESHI

Applicant:

NISSAN CHEMICAL IND LTD

Classification:

- International:

C09D183/04; C03C17/30; C09D183/08; C09K3/18;

G02B1/11

- european:

Application number: JP19960309020 19961120

Priority number(s): JP19960309020 19961120; JP19950313999 19951201

Report a data error here

#### Abstract of JP9208898

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain a coating film which closely adheres to a substrate and having a low refractive index and a large angle of contact with water by heat- curing a coating film of a solution of a polysiloxane prepared by cocondensing an alkoxy organosilicon having a specified composition in the absence of water on the surface of a substrate. SOLUTION: A reaction mixture is formed by mixing a silicon compound (A) represented by formula I (wherein R is a 1-5 C alkyl) with a silicon compound (B) represented by formula I (wherein R<1> is a 1-5 C alkyl; and (n) is 0-12), a 1-13 C alkyl alcohol (C) and oxalic acid (D) in such amounts that 0.05-0.43mol of B is present per mol of A, 0.5-100mol of C and 0.2-2mol of D are present per mol of the total alkoxyls of A and B, and 0.5-10wt.% (in terms of the Si atom) SiO2 is present. This solution is heated to 50-180 deg.C in the absence of water until the total residual amount of A and B decreases to 5mol% or below to form a polysiloxane solution. A coating fluid containing this solution is applied, and the coating film is heat-cured at 80-450 deg.C to obtain a coating film having a refractive index of 1.28 and an angle of contact with water of 90-115 degrees. This film is useful as an antireflection film.

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

(19)日本国特許庁(JP)

# (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平9-208898

(43)公開日 平成9年(1997)8月12日

(51) Int. C1. 6		識別記号	庁内整理番号		FI			技	術表示箇所
C 0 9 D	183/04	PMS			C09D	183/0	PMS		
C03C	17/30				C03C	17/3	. в		
C 0 9 D	183/08				C09D	183/0	3		
C 0 9 K	3/18	104		•	C09K	3/18	3 104		
G 0 2 B	1/11				G 0 2 B	1/10	) A		
	審査請求	未請求 請求	項の数6	OL		•	(全9頁)	-	
(21)出願番号	特原	頁平8−309020			(71)出願人		003986		
(22)出願日 平成8年(1996)11月20			20日				化学工業株式会 都千代田区神田		7番地1
					(72)発明者	f 野上	達哉		
(31)優先権主張番号 特願平7-313999						千葉	県船橋市坪井町7	722番地1	日産化学工
(32)優先日	平7	(1995)12月1日		ļ		業株	式会社中央研究所	<b>听内</b>	
(33)優先権主張	国 日本	z (lb)			(72)発明者	中田	孝和		
				ŀ		千葉	県船橋市坪井町7	22番地1	日産化学工
-						業株	式会社中央研究	<b>听内</b>	20
				-	(72)発明者	酒井	里枝		
•						千葉	県船橋市坪井町7	22番地1	日産化学工
	·	•				業株	式会社中央研究所	听内	· 4.
			•						<b>የ</b> ⁄ራ <del>፫</del> ነ ታ <b>ራ</b> ታ ረ

# (54) 【発明の名称】低屈折率及び撥水性を有する被膜

# (57)【要約】

【課題】 基材表面に密着し、且つ、1.28~1.3 8の屈折率と90~115度の水接触角を有する被膜 を、簡便に且つ効率よく形成させること。

【解決手段】  $Si(OR)_4$ で示される珪素化合物と、 $CF_3$ ( $CF_2$ ) $_nCH_2CH_2Si(OR^1)_3$ で示される珪素化合物と、 $R^2CH_2OH$ で示されるアルコールと、蓚酸とを特定比率に含有する反応混合物を水の不存在下に $50\sim180$ ℃で加熱することによりポリシロキサンの溶液を生成させ、当該溶液を含有する塗布液を基材表面に塗布し、そしてその塗膜を $80\sim450$ ℃で熱硬化させることにより当該基材表面に密着して形成され、且つ、 $1.28\sim1.38$ の屈折率と $90\sim115$ 度の水接触角を有する被膜、

【特許請求の範囲】.

\*【請求項1】 下記一般式(1)

Si(OR) 4

(但し、Rは1~5個の炭素原子を有するアルキル基を

表す。)で示される珪素化合物(A)と、下記一般式 ※

CF<sub>3</sub> (CF<sub>2</sub>) h CH<sub>2</sub> CH<sub>2</sub> S i (OR<sup>1</sup>) s · · ·

★示される珪素化合物(B)と、下記一般式(3) (但し、 $R^1$  は、 $1\sim5$  個の炭素原子を有するアルキル 基を表し、そしてnは、0から12の整数を表す。)で☆

> R<sup>2</sup> CH<sub>2</sub> OH · · · · (3)

(但し、R<sup>2</sup> は、水素原子又は1~12個の炭素原子を す。)で示されるアルコール(C)と、蓚酸(D)と を、珪素化合物 (A) 1モルに対して珪素化合物 (B) 0.05~0.43モルの比率に、珪素化合物(A)と 珪素化合物(B)に含まれる全アルコキシ基1モルに対 してアルコール (C) 0. 5~100モルの比率に、そ して珪素化合物(A)と珪素化合物(B)に含まれる全 アルコキシ基1モルに対して蓚酸(D)0.2~2モル の比率に含有する反応混合物を形成させ、そしてこの反 応混合物を、その中の珪素原子から換算された0.5~ 10重量%のSiO2 濃度に維持すると共に水の不存在 20 を維持しながら、当該反応混合物中珪素化合物(A)及 び珪素化合物(B)の全残存量が5モル%以下となるま でで5.0~1.80℃で加熱することにより、これにより 生じたポリシロキサンの溶液を生成させ、次いで当該ポ リシロキサンの溶液を含有する塗布液を基材表面に塗布 し、そしてこの塗布により得られた塗膜を80~450 ℃で熱硬化させることを特徴とする、1.28~1.3 8の屈折率と90~115度の水接触角を示す被膜を当 該基材表面に密着して形成させる方法。

【請求項2】 反応混合物の形成において、珪素化合物 (A)、珪素化合物(B)、アルコール(C)及び蓚酸 (D) の他に、変成剤 (E) としてメチルトリメトキシ シラン、メチルトリエトキシシラン、エチルトリメトキ シシラン、エチルトリエトキシシラン、プロピルトリメ トキシシラン、プロピルトリエトキシシラン、ブチルト☆

☆リメトキシシラン、ブチルトリエトキシシラン、ペンチ 有する非置換の若しくは置換基を有するアルキル基を表 10 ルトリメトキシシラン、ペンチルトリエトキシシラン、 ヘプチルトリメトキシシラン、ヘプチルトリエトキシシ ラン、オクチルトリメトキシシラン、オクチルトリエト キシシラン、ドデシルトリメトキシシラン、ドデシルト リエトキシシラン、ヘキサデシルトリメトキシシラン、 ヘキサデシルトリエトキシシラン、オクタデシルトリメ トキシシラン、オクタデシルトリエトキシシラン、フェ ニルトリメトキシシラン、フェニルトリエトキシシラ ン、ビニルトリメトキシシラン、ビニルトリエトキシシ ラン、ャーアミノプロピルトリメトキシシラン、ャーア ミノプロピルトリエトキシシラン、ャーグリシドキシプ ロピルトリメトキシシラン、ソーグリンドキシプロピル トリエトキシシラン、γーメタクリロキシプロピルトリ メトキシシラン、ァーメタクリロキシプロピルトリエト キシシラン、ジメチルジメトキシシラン及びジメチルジ エトキシシランからなる群から選ばれる少なくとも一種 のアルキルアルコキシシランを珪素化合物(A)1モル に対して0.02~0.2モルの比率に併用する請求項 1記載の方法。

> 【請求項3】 塗布液の添加物 (F) として、シリカン ル。アルミナソル、チタニアソル、ジルコニアソル、フ ッ化マグネシウムゾル及びセリアゾルからなる群から選 ばれる少なくとも一種のソルを併用する請求項1又は2 記載の方法。

【請求項4】 下記一般式(1)

(1)Si (OR) 4

(但し、Rは1~5個の炭素原子を有するアルキル基を (2) 表す。)で示される珪素化合物(A)と、下記一般式 🧇

 $CF_3$  ( $CF_2$ ) n  $CH_2$   $CH_2$  Si ( $OR^1$ ) 3 · · ·

(但し、R<sup>1</sup> は、1~5個の炭素原子を有するアルキル 40\*示される珪素化合物(B)と、下配一般式(3) 基を表し、そしてnは、0から12の整数を表す。)で\*

R<sup>2</sup> CH<sub>2</sub> OH · · · ·

(但し、R<sup>2</sup> は、水素原子又は1~12個の炭素原子を 有する非置換の若しくは置換基を有するアルキル基を表 す。) で示されるアルコール (C) と、蓚酸 (D) と を、珪素化合物(A)1モルに対して珪素化合物(B) 0. 05~0. 43モルの比率に、珪素化合物(A)と 珪素化合物 (B) に含まれる全アルコキシ基1モルに対 してアルコール(C)0.5~100モルの比率に、そ して珪素化合物(A)と珪素化合物(B)に含まれる全 50

アルコキシ基1モルに対して蓚酸(D)0.2~2モル の比率に含有する反応混合物を形成させ、そしてこの反 応混合物を、その中の珪素原子から換算された0.5~ 10重量%のSiO2 濃度に維持すると共に水の不存在 を維持しながら、当該反応混合物中珪素化合物(A)及 び珪素化合物(B)の全残存量が5モル%以下となるま で、50~180℃で加熱することにより、これにより 生じたポリシロキサンの溶液を生成させ、次いで当該ポ

(3)

Q

リシロキサンの溶液を含有する塗布液を基材表面に塗布し、そしてこの塗布により得られた塗膜を80~450℃で熱硬化させることにより上記基材表面に密着して形成され、且つ、1.28~1.38の屈折率と90~115度の水接触角を示す被膜。

【請求項5】 反応混合物の形成において、珪素化合物 (A)、珪素化合物(B)、アルコール(C)及び蓚酸 (D) の他に、変成剤 (E) としてメチルトリメトキシ シラン、メチルトリエトキシシラン、エチルトリメトキ シシラン、エチルトリエトキシシラン、プロピルトリメ トキシシラン、プロピルトリエトキシシラン、プチルト リメトキシシラン、プチルトリエトキシシラン、ペンチ ルトリメトキシシラン、ペンチルトリエトキシシラン、 ヘプチルトリメトキシシラン、ヘプチルトリエトキシシ ラン、オクチルトリメトキシシラン、オクチルトリエト キシシラン、ドデシルトリメトキシシラン、ドデシルト リエトキシシラン、ヘキサデシルトリメトキシシラン、 ヘキサデシルトリエトキシシラン、オクタデシルトリメ トキシシラン、オクタデシルトリエトキシシラン、フェ ニルトリメトキシシラン、フェニルトリエトキシシラ ン、ビニルトリメトキシシラン、ビニルトリエトキシシ ラン、ソーアミノプロピルトリメトキシシラン、ソーア ミノプロピルトリエトキシシラン、ャーグリシドキシプ ロピルトリメトキシシラン、ャーグリシドキシプロピル トリエトキシシラン、ャーメタクリロキシプロピルトリ メトキシシラン、γーメタクリロキシプロピルトリエト キシシラン、ジメチルジメトキシシラン及びジメチルジ エトキシシランからなる群から選ばれる少なくとも一種 のアルキルアルコキシシランを珪素化合物(A) 1モル に対して0.02~0.2モルの比率に併用する請求項 30 4記載の被膜。

【請求項6】 塗布液の添加物(F)として、シリカゾ アルミナゾル、チタニアゾル、ジルコニアゾル、フ ッ化マグネシウムゾル及びセリアゾルからなる群から選 ばれる少なくとも一種のゾルを併用する請求項4又は5 記載の被膜。

#### 【発明の詳細な説明】

#### [0001]

【発明の属する技術分野】 本発明は、アルコキシ基含有珪素化合物のポリマー溶液から基材上に形成される被 40 膜の改良に関する。特に本発明は、特定組成を有するアルコキシ基含有珪素化合物を水の不存在下に共縮合させてなるポリシロキサンの溶液からなる強膜を、基材表面上で熱硬化させることにより当該基材表面に密着して形成され、且つ、低屈折率及び大きい水接触角を有する被膜に関する。

### [0002]

【従来の技術】 従来より、基材の屈折率よりも低い屈 折率を示す被膜を当該基材の表面に形成させると、当該 被膜の表面から反射する光の反射率が低下することが知 50

られている。そしてこのような低下した光反射率を示す 被膜は、光反射防止膜として利用され、種々の基材表面 に適用されている。特開平5-105424号公報に は、Mg源としてのマグネシウム塩、アルコキシマグネ シウム化合物などと、F源としてのフッ化物塩とを反応 させることにより生成させたMgF2 微粒子のアルコー ル分散液、又はこれに膜強度向上のためにテトラアルコ キシシランなどを加えた液を塗布液とし、これをブラウン管等ガラス基材上に塗布し、そして100~500℃ で熱処理することにより、当該基材上に低屈折率を示す 反射防止膜を形成させる方法が開示されている。

【0003】特開平6-157076号公報には、テトラアルコキシシラン、メチルトリアルコキシシラン、エチルトリアルコキシシランなどの加水分解縮重合物であって、平均分子量の異なる2種以上とアルコール等溶剤とを混合することによりコーティング液となし、当該コーティング液から被膜を形成するに当たって上記混合の際の混合割合、相対湿度のコントロールなどの手段を加えて被膜をつくり、そしてこれを加熱することにより、1.21~1.40の屈折率を示し、且つ、50~200nmの径を有するマイクロピット又は凹凸を有する厚さ60~160nmの薄膜を、ガラス基板上に形成させた低反射ガラスが開示されている。

【0004】特公平3-23493号公報には、ガラスと、その表面に形成させた高屈折率を有する下層膜と、更にその表面に形成させた低屈折率を有する上層膜とからなる低反射率ガラスが開示されている。この公報には、その上層膜の形成方法の詳細として、CF3(CF2) $_2$ C $_2$ H $_4$ Si(OCH $_3$ ) $_3$ 等ポリフルオロカーボン鎖を有する含フッ素シリコーン化合物と、これに対し5~90重量%のSi(OCH $_3$ ) $_4$ 等シランカップリング剤とを、アルコール溶媒中、酢酸等触媒の存在下に室温で加水分解させた後、濾過することにより共縮合体の液を調製し、次いでこの液を上記下層膜上に塗布し、120~250℃で加熱することからなる方法が記載されている。

#### [0005]

【発明が解決しようとする課題】上記特公平3-234 93号公報に記載の、基材上に多層に被膜を形成させる 方法では、塗布工程と焼成工程を繰り返す必要があり効 率的でないのみならず、焼成工程の繰り返しによって、 被膜にクラックが生じたり、生成被膜も不均一になりや すく、更に基材の変形も起こりやすい。更にこの加水分 解の方法で得られる塗布液から形成される上層膜に低い 屈折率を付与するには、シランカップリング剤1モルに 対して1.1モル以上もの多量の含フッ素シリコーン化 合物の使用を必要とし、このような場合でも1.33よ り低い屈折率を有する被膜は得られない。そしてこの加 水分解の方法で得られる塗布液を直接に基材の上に塗布 し、そしてその塗膜を加熱する方法によって得られた被

膜は、十分な硬度を有しない。

【0006】上記特開平5-105422号公報に記載 の方法では、MgF2微粒子間の結合力が弱いため、形 成された被膜は機械的強度に乏しく、そして基材との密 着力も十分でないのみならず、MgF2からなるこの被 膜は本質的に1.38より小さい屈折率を示さず、基材 の種類によっては十分な光反射防止性を発現しない。上 記特開平6-157076号公報に記載の方法では、異 なる分子量を有する縮合物の製造、その配合などにかな りの煩雑さを伴い、更に被膜形成時に相対湿度、被膜表 10 面凹凸のコントロールなどを要し、この方法は実用性に 乏しい。

【0007】上記特開平5-105422号公報に記載\*

(但し、Rは1~5個の炭素原子を有するアルキル基を 表す。) で示される珪素化合物(A)と、下記一般式 ※

 $CF_3$   $(CF_2)_n$   $CH_2$   $CH_2$  Si  $(OR^1)_3$  · · ·

(但し、R1は、1~5個の炭素原子を有するアルキル 基を表し、そしてnは、0から12の整数を表す。)で★

(但し、R<sup>2</sup> は、水素原子又は1~12個の炭素原子を 有する非置換の若しくは置換基を有するアルキル基を表 す。)で示されるアルコール(C)と、蓚酸(D)と を、珪素化合物(A) 1 モルに対して珪素化合物(B) 0.05~0.43モルの比率に、珪素化合物(A)と 珪素化合物 (B) に含まれる全アルコキシ基1モルに対 してアルコール (C) 0. 5~100モルの比率に、そ して珪素化合物(A)と珪素化合物(B)に含まれる全 アルコキシ基1モルに対して蓚酸(D) O. 2~2モル の比率に含有する反応混合物を形成させ、そしてこの反 30 応混合物を、その中の珪素原子から換算された0.5~ 10重量%のSiO2 濃度に維持すると共に水の不存在 を維持しながら、当該反応混合物中珪素化合物(A)及 び珪素化合物 (B) の全残存量が5モル%以下となるま で、50~180℃で加熱することにより、これにより 生じたポリシロキサンの溶液を生成させ、次いで当該ポ リシロキサンの溶液を含有する塗布液を基材表面に塗布 し、そしてこの塗布により得られた塗膜を80~450 ℃で熱硬化させることにより上記基材表面に密着して形 成され、そしてこの被膜は1.28~1.38の屈折率 40 及び90~115度の水接触角を示す。

【0009】上記ポリシロキサンの溶液は透明であっ て、ゲル状のポリシロキサンは含有していない。多量の アルコール(C)と比較的多量の蓚酸(D)とは共存す るが、水が存在しない反応混合物中で珪素化合物(A) と珪素化合物 (B) とは加熱されるから、このポリシロ キサンは、珪素化合物(A)と珪素化合物(B)の加水 分解物の縮合によって生成したものではない。アルコー ル溶媒中加水分解の方法でアルコキシシランからポリシ \*の被膜、上記特開平6-157076号公報に記載の被 膜のいずれも、その表面は実用中に汚れやすく、これを 防止するために、その表面に更に撥水性の高い処理剤、 例えば、含フッ素化合物からなる防汚処理剤を塗布する ことが行われている。本発明は、簡便に且つ効率よく、 基材上に改良された被膜を形成させる方法を提供しよう とするものであり、特に、基材上に、1.28~1.3 8の屈折率と90~115度の水接触角を示し、且つ、 当該基材の表面に密着して形成された被膜を提供しよう とするものである。

#### [0008]

本発明の被膜は、下記 【課題を解決するための手段】

(1)

★示される珪素化合物(B)と、下記一般式(3)

液に濁りが生じたり、不均一なポリシロキサンが生成し やすいが、本発明による上記反応混合物ではそのような ことは起こらない。

【0010】本発明による上記ポリシロキサンは、その 化学構造は複雑であって特定しがたいが、おそらく珪素 化合物(A)及び珪素化合物(B)と蓚酸(D)との反 応により生成した中間体にアルコール(C)が作用して 重合が進行するために、分岐構造は有していても、溶液 を形成する程度の重合度を有し、そして比較的に揃った 構造を有する珪素化合物(A)と珪素化合物(B)の共 縮合体ポリシロキサンが生成するものと考えられる。

【0011】基材上に塗布された上記ポリシロキサンの 溶液を含有する塗膜の加熱により、当該塗膜から揮発成 分の除去と当該塗膜中でポリシロキサンの硬化反応が進 行することによって、当該基材表面に密着し、そして低 屈折率と撥水性を有する不溶性の被膜が生成する。珪素 化合物 (A) の量に対する珪素化合物 (B) の量のモル 比が大きい程、この被膜の屈折率は低くなり、そして水 との接触角は大きくなる。けれども、本発明の被膜は、 前記特公平3-23493号公報に記載の上層膜とは相 違して、珪素化合物(B)の含有率の低い塗布液から形 成されるにも係わらず、上記上層膜の示す屈折率より低

## [0012]

い屈折率を有する。

【発明の実施の形態】 前記一般式(1)に含まれるア ルキル基Rの例としては、メチル、エチル、プロピル、 ブチル、ペンチルなどが挙げられ、好ましい珪素化合物 · (A) の例としては、テトラメトキシシラン、テトラエ トキシシラン、テトラプロポキシシラン、テトラプトキ ロキサンを生成させるときは、加水分解の進行につれて 50 シシランなどが挙げられる。これらの中でもテトラメト

キシシラン、テトラエトキシシランなどが特に好まし ٧V.

【0013】前記一般式(2)に含まれるアルキル基R 1 の例としては、メチル、エチル、プロピル、ブチル、 ペンチルなどが挙げられ、好ましい珪素化合物(B)の 例としては、トリフルオロプロピルトリメトキシシラ ン、トリフルオロプロピルトリエトキシシラン、トリデ カフルオロオクチルトリメトキシシラン、トリデカフル オロオクチルトリエトキシシラン、ヘプタデカフルオロ デシルトリメトキシシラン、ヘプタデカフルオロデシル 10 トリエトキシシランなどが挙げられ、これらは単独で又 は二種以上組み合わせて用いることができる。

【0014】前記一般式(3)に含まれる非置換のアル キル基R<sup>2</sup> の例としては、メチル、エチル、プロピル、 プチル、ペンチル、ヘキシル、ヘプチル、オクチルなど が挙げられ、そして置換基を有するアルキル基R<sup>2</sup>の例 としては、ヒドロキシメチル、メトキシメチル、エトキ シメチル、ヒドロキシエチル、メトキシエチル、エトキ シエチルなどが挙げられる。好ましいアルコール (C) の例としては、メタノール、エタノール、プロパノー ル、n-ブタノール、エチレングリコールモノメチルエー テル、エチレングリコールモノエチルエーテル、ジエチ レングリコールモノメチルエーテル、ジエチレングリコ ールモノエチルエーテル、プロピレングリコールモノメ チルエーテル、プロピレングリコールモノエチルエーテ ルなどが挙げられ、これらは単独で又は二種以上組み合 わせて用いることができる。これらの中でも特にエタノ ールが好ましい。

【0015】珪素化合物(A)1モルに対して珪素化合 物 (B) を0. 43モル以上使用した反応混合物から は、均一性を有するポリシロキサンの溶液が得られな い。そして珪素化合物(A)1モルに対して珪素化合物 (B) を 0. 0 5 モル以下使用した反応混合物からは、 1. 38以下の屈折率を有する被膜が形成されず、そし てその被膜は、水の接触角90度以上を示す撥水性を示 さない。珪素化合物(A)1モルに対して珪素化合物 (B) を 0. 05~0. 25 モル使用するのが特に好ま しい。

【0016】珪素化合物(A)と珪素化合物(B)に含 まれる全アルコキシ基の1モル当たり、0.5モルより 少ない量のアルコールを使用すると、ポリシロキサンを 生成させるのに長時間を要し、そして得られたポリシロ キサン含有液からは、硬度の高い被膜が生成しない。反 対に、珪素化合物(A)と珪素化合物(B)に含まれる 全アルコキシ基の1モル当たり、100モルより多い量 のアルコールを使用すると、得られたポリシロキサン含 有液のSiOa 濃度が不足し、塗布前に濃縮を必要とし 効率的でない。珪素化合物(A)と珪素化合物(B)に 含まれる全アルコキシ基の1モルに対してアルコールを 1~50モル使用するのが特に好ましい。

【0017】珪素化合物(A)と珪素化合物(B)に含 まれる全アルコキシ基の1モル当たり、0.2モルより 少ない量の蓚酸(D)を使用すると、得られたポリシロ キサン含有液からは、硬度の高い被膜が生成しない。反 対に、珪素化合物(A)と珪素化合物(B)に含まれる 全アルコキシ基の1モル当たり、2モルより多い量の蓚 酸(D)を使用すると、得られたポリシロキサン含有液 中は、相対的に多量の蓚酸(D)を含有し、かかる液か らは目的とする性能の被膜が得られない。珪素化合物 (A) と珪素化合物 (B) に含まれる全アルコキシ基の 1モルに対して、蓚酸(D)を0.25~1モル使用す るのが特に好ましい。

【0018】反応混合物の形成には、上記珪素化合物 (A)、珪素化合物(B)、アルコール(C)及び蓚酸 (D) の他に、所望に応じて、例えば、珪素化合物

(A) 1モルに対して0.02~0.2モル程度の変成 剤 (E) としてのアルキルアルコキシシランを併用して も良い。好ましい変成剤(E)の例としては、メチルト リメトキシシラン、メチルトリエトキシシラン、エチル トリメトキシシラン、エチルトリエトキシシラン、プロ ピルトリメトキシシラン、プロピルトリエトキシシラ ン、ブチルトリメトキシシラン、ブチルトリエトキシシ ラン、ペンチルトリメトキシシラン、ペンチルトリエト キシシラン、ヘプチルトリメトキシシラン、ヘプチルト リエトキシシラン、オクチルトリメトキシシラン、オク チルトリエトキシシラン、ドデシルトリメトキシシラ ン、ドデシルトリエトキシシラン、ヘキサデシルトリメ トキシシラン、ヘキサデシルトリエトキシシラン、オク タデシルトリメトキシシラン、オクタデシルトリエトキ 30 シシラン、フェニルトリメトキシシラン、フェニルトリ エトキシシラン、ビニルトリメトキシシラン、ビニルト リエトキシシラン、γ-アミノプロピルトリメトキシシ ラン、y-アミノプロピルトリエトキシシラン、y-グ リシドキシプロピルトリメトキシシラン、γーグリシド キシプロピルトリエトキシシラン、ソーメタクリロキシ プロピルトリメトキシシラン、ソーメタクリロキシプロ ピルトリエトキシシランなどのトリアルコキシシラン、 及びジメチルジメトキシシラン、ジメチルジエトキシシ ランなどのジアルコキシシランが挙げられる。これらは 単独で又は二種以上組み合わせて用いることができる。

【0019】これらの変成剤(E)は、基材上の途膜を 硬化させるための温度を低下させることができ、そして 被膜の基材に対する密着性を向上させる。上記珪素化合 物(A)、珪素化合物(B)、アルコール(C)及び蓚 酸(D)を含有する反応混合物は、これらを混合するこ とにより、或いはこれらに更に上記変成剤(E)を加え ることにより形成させることができる。この反応混合物 には水は加えられない。そしてこの反応混合物は、好ま しくは溶液状の反応混合物として加熱するのが好まし く、例えば、あらかじめアルコール(C)に蓚酸(D)

**分**特別等

を加えて蓚酸のアルコール溶液を形成させた後、当該溶液と珪素化合物(A)、珪素化合物(B)、上記変成剤(E)などを混合することにより得られる溶液状の反応混合物として加熱するのが好ましい。通常、珪素化合物(A)、珪素化合物(B)、アルコール(C)及び蓚酸

(D) の上記比率の反応混合物は、これに含まれる珪素原子を $SiO_2$  に換算するEVERTING に換算するVVERTING に VVERTING に VVERTING

【0020】ポリシロキサンを生成させるための加熱を 50℃より低い温度で行うと、濁りを有したり、不溶解 物を含有する液が生成しやすいので、この加熱は50℃ より高い温度で行われ、高温ほど短時間に終了させるこ とができる。けれども、180℃より高い温度での加熱 は、付加的利益をもたらさず非効率的である。加熱時間 には特に制限はなく、例えば50℃では8時間程度、7 8℃の還流下では3時間程度で十分であり、通常、珪素 化合物(A)及び珪素化合物(B)の全仕込量に対して これら珪素化合物の残存量が5モル%以下となった時点 で加熱は停止される。用いられた珪素化合物(A)及び 珪素化合物(B)の全量に対してこれら珪素化合物が5 モル%よりも多く残存するポリシロキサン含有液は、こ れを基材表面に塗布し、次いでその塗膜を80から45 0℃で熱硬化させたとき、得られた被膜にピンホールが 生じたり、或いは十分な硬度を有する被膜が得られな 11

【0021】上記加熱により得られたポリシロキサンの 溶液は、そのまま次の塗布工程に塗布液として使用する ことができるが、所望に応じ、濃縮又は希釈することに より得られる液を塗布液として、他の溶媒に置換するこ とにより得られる液を塗布液として、或いは所望の添加 物(F)と混合することにより得られる塗布液として使 用することができる。この添加物 (F) の例として、コ 40 ロイド状無機微粒子のゾルの形態であるシリカゾル、ア ルミナゾル、チタニアゾル、ジルコニアゾル、フッ化マ グネシウムゾル、セリアゾルが挙げられ、これらは単独 で又は二種以上組み合わせて用いることができる。そし て、これらのソルとしてはオルガスソルが好ましく、特 にアルコール (C) を分散媒とするオルガノゾルが特に 好ましい。またゾルの添加量は、塗布液の熱硬化固形分 全重量に対してコロイド状無機微粒子重量が70重量% 以下であれば、所望の量を任意に選ぶことができる。そ の他添加物 (F) としては、金属塩、金属化合物なども 50 挙げられる。これらは被膜の撥水性を調節するのに好都 合である。

【0022】 塗布工程に使用されるこの塗布液としては、その中に上記ポリシロキサンの透明溶液に由来する 珪素原子を $SiO_2$  に換算して $0.5\sim10$  重量%含有する液が好ましく、この $SiO_2$  濃度が0.5 重量%より小さいと、一回の塗布で形成される被膜の厚さが薄くなりやすく、そしてこの濃度が10 重量%より高いと、この塗布液の貯蔵安定性が不足しやすい。この塗布液の $SiO_2$  濃度としては $2\sim8$  重量%が特に好ましい。

【0023】基材としては、この上に密着性被膜の生成を許容するものであれば特に制限はないが、特に光反射防止被膜を形成させるには、通常のガラス、プラスチックなど被膜の屈折率より高い屈折率を有する基材が望ましい。上記ポリシロキサンの溶液又はこれを含有する塗布液は、通常の方法、例えば、ディップ法、スピンコート法、刷毛塗り法、ロールコート法、フレキソ印刷法などで基材上に塗布することができる。

【0024】基材上に形成された塗膜は、そのまま熱硬化させても良いが、これに先立ち室温~80℃、好ましくは50~80℃で乾燥させた後、80~450℃、好ましくは、100~450℃で加熱される。この加熱の時間としては5~60分程度で十分である。この加熱温度が80℃より低いと、得られた被膜の硬度、耐薬品性などが不足しやすい。一般にガラスのような耐熱性基材に対しては、300℃以上の温度で加熱するのが良いが、450℃より高い温度は、得られた被膜に十分な撥水性を与えない。これら加熱は、通常の方法、例えばホットプレート、オーブン、ベルト炉などを使用することにより行うことができる。

#### [0.025]

#### 【実施例】

#### 実施例1

選流管を備えつけた4つ口反応フラスコにエタノール70.8gを投入し、撹拌下にこのエタノールに蓚酸12.0gを少量づつ添加することにより、蓚酸のエタノール溶液を調製した。次いでこの溶液をその還流温度まで加熱し、選流下のこの溶液中にテトラエトキシシラン11.0gとトリデカフルオロオクチルトリメトキシシラン6.2gの混合物を滴下した。滴下終了後も、還流下に加熱を5時間続けた後冷却することによりポリシロキサンの溶液(L<sub>1</sub>)を調製した。

【0026】この溶液(L<sub>1</sub>)をガスクロマトグラフィーで分析したところ、アルコキシドモノマーは検出されなかった。この溶液(L<sub>1</sub>)をフッ化カルシウム基板の表面に塗布した後、その塗膜を300℃で30分加熱することにより、このフッ化カルシウム基板の表面に密着した被膜を生成させた。次いでこの被膜について、赤外線分光器を使用して透過光のスペクトルを測定したところ、3200cm<sup>-1</sup>付近と980cm<sup>-1</sup>付近にシラノー

12

ル基による吸収を、2800cm<sup>-1</sup>付近にメチレン基に よる吸収を、1100 c m<sup>-1</sup>付近にS i -O-S i によ る吸収を、そして1200cm<sup>-1</sup>付近にC-Fによる吸 収をそれぞれ観測した。

#### 【0027】実施例2

還流管を備えつけた4つ口反応フラスコにエタノール7 2. 4gを投入し、撹拌下にこのエタノールに蓚酸1 2.0gを少量づつ添加することにより、蓚酸のエタノ ール溶液を調製した。次いでこの溶液をその還流温度ま で加熱し、還流下のこの溶液中にテトラエトキシシラン 10 12.5gとトリデカフルオロオクチルトリメトキシシ ラン3.1gの混合物を滴下した。滴下終了後も、還流 下に加熱を5時間続けた後冷却することによりポリシロ キサンの溶液  $(L_2)$  を調製した。この溶液  $(L_2)$  を ガスクロマトグラフィーで分析したところ、アルコキシ ドモノマーは検出されなかった。

#### 【0028】実施例3

還流管を備えつけた4つ口反応フラスコにエタノール7 0.6gを投入し、撹拌下にこのエタノールに蓚酸1 2.0gを少量づつ添加することにより、蓚酸のエタノ ール溶液を調製した。次いでこの溶液をその還流温度ま で加熱し、還流下のこの溶液中に、テトラエトキシシラ ン9. 4 g と トリデカフルオロオクチルトリメトキシシ ラン6.2gとャーグリシドキシプロピルトリメトキシ シラン1.2gとyーアミノプロピルトリメトキシシラ ン0.6gの混合物を滴下した。滴下終了後も、還流下 に加熱を5時間続けた後冷却することによりポリシロキ サンの溶液(L<sub>3</sub>) を調製した。この溶液(L<sub>3</sub>) をガ スクロマトグラフィーで分析したところ、アルコキシド モノマーは検出されなかった。

#### 【0029】 実施例4

実施例3で得られた溶液 (L<sub>s</sub>) 100gに、粒子径8 nmのコロイド状シリカをSiO2として15.7重量 %含有するメタノール分散シリカゾルを51.0gとエ タノール149gを加えて十分に混合することにより、 ポリシロキサンの溶液(La) を調製した。

#### 【0030】実施例5

実施例3で得られた溶液(L3)100gに、粒子径8 nmのコロイド状シリカをSiO2として15.7重量 %含有するメタノール分散シリカゾルを76.4gとエ 40 タノール223.6gを加えて十分に混合することによ り、ポリシロキサンの溶液(Ls) を調製した。

#### 【0031】比較例1

還流管を備えつけた4つ口フラスコにエタノール43. 7gとテトラエトキシシラン16.6gとトリデカフル オロオクチルトリメトキシシラン9.3gを投入して混 合することによりエタノール溶液を調製した。次いでこ の溶液をその還流温度まで加熱し、還流下のこの溶液 に、エタノール24.9gと水5.4gと触媒として硝 酸 0.1 g の混合物を滴下した。滴下終了後も、還流下 50 に5時間加熱を続けた後冷却することにより、アルコキ シシランの加水分解物からなる液(L<sub>6</sub>) を調製した。 【0032】比較例2

還流管を備えつけた4つ口反応フラスコにエタノール7 2.0gを投入し、撹拌下のこのエタノールに蓚酸1 1.4gを少量づつ添加することにより、蓚酸のエタノ ール溶液を調製した。次いでこの溶液をその還流温度ま で加熱し、還流下のこの溶液に、テトラエトキシシラン 11.0gとオクタデシルトリメトキシシラン5.6g の混合物を滴下した。滴下終了後も、還流下に5時間加 熱を続けた後冷却することによりポリシロキサン含有液 (L<sub>7</sub>) を調製した。

#### 【0033】比較例3

還流管を備えつけた4つ口反応フラスコにエタノール5 3. 7gとテトラエトキシシラン20.8gを投入して 混合することにより、テトラエトキシシランのエタノー ル溶液を調製した。次いでこの溶液をその還流温度まで 加熱し、還流下のこの溶液に、エタノール20.0gと 水5.4gと触媒として硝酸0.1gの混合物を滴下し た。滴下終了後も、還流温度で5時間加熱を続けた後冷 却することによりアルコキシシランの加水分解物からな る液を調製した。次いでこの液全量に、粒子径12nm のコロイド状シリカをSiO2として30重量%含有す るメタノール分散シリカゾルを100gとエタノール7 00gを加えて十分に混合することにより、混合液 (L a) を調製した。

#### 【0034】実施例6

上記液 (L<sub>1</sub>) ~ (L<sub>8</sub>) を塗布液として、それぞれ基板 上にスピンコートして塗膜を形成させた後、この塗膜を ホットプレート上80℃で5分乾燥し、次いで焼成炉中 表1に示す温度で加熱することにより、基板表面上に被 膜を形成させた。次いで得られた被膜について、下記方 法により鉛筆硬度、屈折率、反射率、水接触角及び膜厚 の各測定を行った。

【0035】上記鉛筆硬度の測定及び反射率の測定で は、被膜は、1.52の屈折率と4~5%の反射率を有 するソーダライムガラス基板の表面に形成され、そして 上記屈折率の測定では、被膜はシリコン基板の表面に形 成された。

鉛筆硬度の測定法: JIS K 5400 に規定の 方法による。

屈折率の測定法 : 溝尻光学(株)製のエリプソメタ 一DVA-36Lを使用して、波長633mmの光の屈 折率を測定した。

【0036】反射率の測定法 : (株) 島津製作所製 の分光光度計UV3100PCを使用して、波長550 nmの光の入射角5度での光の反射率を測定した。 水接触角の測定法: 協和界面科学(株)製の自動接触 角計CA-2型を使用して、純水3マイクロリットルを

滴下したときの接触角を測定した。